

拒絶査定

特許出願の番号	平成11年 特許願 第352847号
起案日	平成15年 4月18日
特許庁審査官	正山 旭 9276 4M00
発明の名称	半導体装置及びその製造方法並びに製造に用いるマスク
特許出願人	NECエレクトロニクス株式会社
代理人	鈴木 章夫

この出願については、平成14年 1月11日付け拒絶理由通知書に記載した理由2によって、拒絶をすべきものである。

なお、意見書及び手続補正書の内容を検討したが、拒絶理由を覆すに足りる根拠が見いだせない。

備考

出願人は意見書において、上記拒絶理由で引用した、各引用文献には、いずれにもダミー領域を本願発明のように「絶縁材を埋め込んだ溝により行列状に配置された複数の島状に形成する技術」については何ら開示されておらず、本願発明のように「CMP法によってダミー領域や素子分離領域を形成する際の平坦性を確保することは困難である」と主張している。

しかしながら、溝素子分離をCMP法によって形成する際に、平坦性の確保のために、絶縁材で埋め込んだ溝により行列状に配置された複数の島状のダミー領域を形成することは周知の技術（必要ならば、特開平10-092921号公報[特に、第6図、第7図]、特開平09-181159号公報[特に、第1図、第2図]等を参照されたい。）であるから、上記拒絶理由で引用した各引用文献に記載の発明において、CMP法における平坦性の確保のために上記の周知技術を組み合わせることは、当業者にとって格別な困難性を有するものとは認められないため、出願人の主張は採用しない。

なお、審判請求時に補正を行う際には、補正で付加できる事項は、この出願の出願当初の明細書又は図面に記載した事項のほか、出願当初の明細書又は図面に記載した事項から当業者が直接的かつ一義的に導き出すことができる事項に限られ、且つ特許請求の範囲の限定的減縮、不明瞭な記載の釈明又は誤記の訂正を目的とする補正に限られることに注意し、審判請求の理由で、各補正事項について補正が適法なものである理由を、根拠となる出願当初の明細書の記載箇所を明確に示したうえで主張されたい。審判請求の理由の記載は、特許異議申立における訂正請求書の記載形式を参考にされたい。また、明細書を補正した場合は、補正

発送番号 135681

発送日 平成15年 5月 6日 2 / 2

により記載を変更した個所に下線を引くこと（特許法施行規則様式第13備考6）。

上記はファイルに記録されている事項と相違ないことを認証する。

認証日 平成15年 4月21日 経済産業事務官 塚本 佳雅